





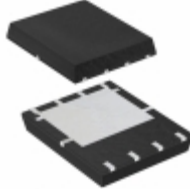
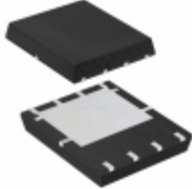

	<h2>RS1E350BNTB</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RS1E350BNTB</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 35A 8HSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RS1E350BNTB.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RS1E350BNTB</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A 8HSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.7 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 35W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7900pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	185nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A

RS1E350BNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RS1E350BNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RS1E350BNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RS1E350BNTB E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RS1G F3</b> TSC RS1G F3 TSC</p>	 <p><b>RS1G</b> Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 400V 1A SMA</p>	 <p><b>RS1E350BN</b> QQ2850920316 RS1E350BN QQ2850920316</p>	 <p><b>RS1E320GN</b> ROHM RS1E320GN ROHM</p>
 <p><b>RS1G M2G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p><b>RS1E320GNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 32A 8-HSOP</p>	 <p><b>RS1E300GNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 30A 8-HSOP</p>	 <p><b>RS1E350BNFU7TB</b> ROHM RS1E350BNFU7TB ROHM</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RS1E350BNTB LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">RS1E350BNTB Datenblatt</a>	<a href="#">RS1E350BNTB-Datenblätter</a>	<a href="#">RS1E350BNTB PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor RS1E350BNTB</a>
<a href="#">RS1E350BNTB Electronic</a>	<a href="#">RS1E350BNTB-Komponenten</a>	<a href="#">RS1E350BNTB-Verteiler</a>	<a href="#">RS1E350BNTB-Bild</a>	<a href="#">RS1E350BNTB-Teil</a>
<a href="#">RS1E350BNTB Preis</a>	<a href="#">RS1E350BNTB Hersteller</a>	<a href="#">RS1E350BNTB Bild</a>	<a href="#">RS1E350BNTB Aktie</a>	<a href="#">RS1E350BNTB Inventar</a>
<a href="#">RS1E350BNTB Neu</a>	<a href="#">RS1E350BNTB Original</a>	<a href="#">RS1E350BNTB garantiert</a>	<a href="#">RS1E350BNTB RFQ</a>	<a href="#">RS1E350BNTB Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited